

## (12) ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

<p>(21) เลขที่คำขอ 1601002968</p> <p>(22) วันที่ยื่นคำขอ 25 พฤษภาคม 2559</p>	<p>(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.Cl.10 C04B 35/28</p>
<p>(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก -</p> <p>(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก -</p> <p>(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก -</p>	<p>(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร นายปิ่นกมล เรืองเดช</p> <p>(72) ผู้ประดิษฐ์ นายปิ่นกมล เรืองเดช</p> <p>(74) ตัวแทน นายจिरโรจน์ สีสรรพ์ แห่ง บริษัท ทีจีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่อยู่เลขที่ 301/46 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000</p>
<p>(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์</p>	<p>กระบวนการในการเตรียมซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) แบตเตอรี่กราฟีนออกไซด์ (graphene oxide)</p>
<p>(57) บทสรุปการประดิษฐ์</p>	<p>กระบวนการในการเตรียมซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) แบตเตอรี่กราฟีนออกไซด์ (graphene oxide) มีลักษณะที่ ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) ประกอบด้วยวัสดุ แบตเตอรี่กราฟีน ออกไซด์ (graphene oxide) โดยเปรียบเทียบกับกราฟีน ออกไซด์ (graphene oxide) ในรูปแบบชั้นเดียวของกราฟไฟท์ที่มีพื้นผิวมากเนื่องจากมีขนาดเล็กระดับนาโนและมีความแข็งแรง มีลักษณะพิเศษคือ กระบวนการในการเตรียมความพร้อม ซูเปอร์คาปาซิเตอร์ (Super Capacitor) แบตเตอรี่กราฟีน ออกไซด์ (graphene oxide) ประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมความพร้อมของวัสดุคาร์บอนและวัสดุลิเทียมไอออนเป็นวัสดุที่ใช้งาน ขั้วบวกวัสดุที่ใช้งานขั้วบวกมากกว่า เนื้อของวัสดุคาร์บอนเท่ากับ 70% และน้อยกว่า 100% ซิลิกอน นาโนไว (Silicon Nanowires) ที่มีอัตราส่วนมวลกับกราฟีนออกไซด์ (graphene oxide) ~ 20: 80 ~ 99 เตรียมเป็นวัสดุที่ใช้งานขั้วลบ</p>
<p>(ข้อถือสิทธิ 1 ข้อ, รูปเขียน 0 รูป)</p>	